

Vorläufige technische Daten

Kapazitätsvariationsdiode

Meßwerte

bei Umgebungstemperatur $t_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$

a) statisch

Sperrstrom $-I_d (-U_d = 10\text{ V}) \quad 0,01 < 0,1 \quad \mu\text{A}$

b) dynamisch

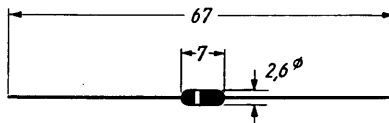
bei $-U_d = 10\text{ V}$, $U_{HF} \leq 50\text{ mV}$, $f = 30\text{ MHz}$

Bahnwiderstand	r_b	$2 < 3$	Ω
Sperrschichtkapazität	c_j	$> 10 \quad 25 < 35$	pF
Induktivität	L_{ak}	7	nHy
Thermischer Widerstand	R_{therm}	$< 0,5$	$^{\circ}\text{C/mW}$

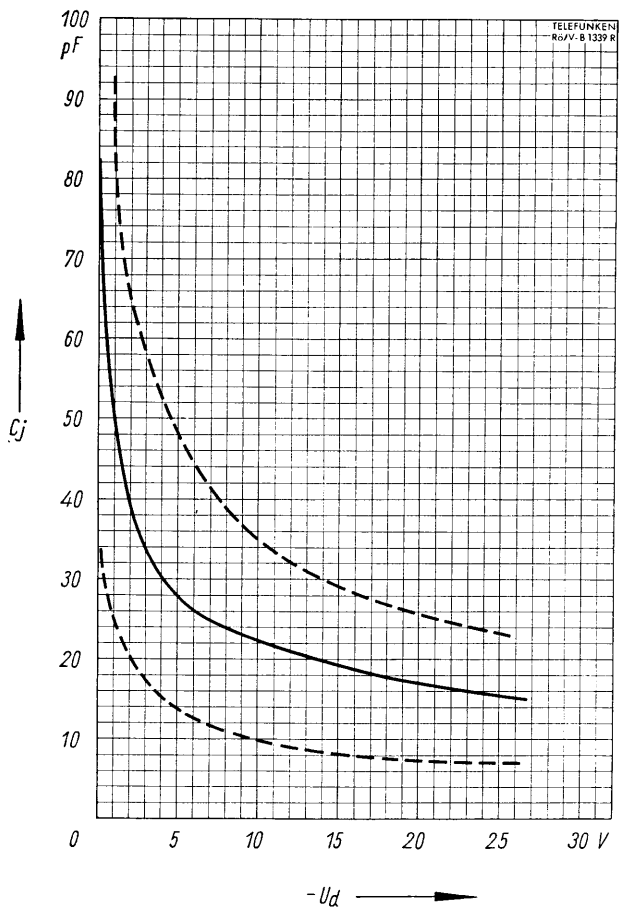
Grenzwerte

Sperrspannung	$-U_d$	25	V
Verlustleistung	P_d	250	mW
bei $t_{amb} = 45^{\circ}\text{C}$ und Betrieb in ruhender Luft			
Sperrschichttemperatur	t_j	175	$^{\circ}\text{C}$

max. Abmessungen



Gewicht: max. 0,3 g



$c_j = f(-U_d)$

$t_{amb} = 25^\circ\text{C}$

— Mittelwert - - - - - Streuwerte

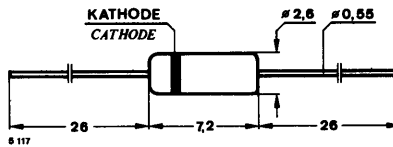
95% der Fertigung liegen innerhalb der angegebenen Grenzen

Silizium-Diffusions-Kapazitäts-Diode Silicon diffusion capacitance diode

Anwendungen: Automatische Nachstimmaltungen in VHF-Tunern

Applications: AFC in VHF tuner

**Abmessungen in mm
Dimensions in mm**



Normgehäuse
Case
51 A 2 DIN 41 880
JEDEC DO 7
Gewicht · Weight
max. 0,2 g

Absolute Grenzdaten Absolute maximum ratings

Sperrspannung Reverse voltage	U_R	20	V
Sperschichttemperatur Junction temperature	t_j	150	°C
Lagerungstemperaturbereich Storage temperature range	t_{stg}	-50...+150	°C

BA 111

Kenngrößen Characteristics

Min. Typ. Max.

$$t_j = 25^\circ\text{C}$$

Durchlaßspannung
Forward voltage

$$I_F = 60 \text{ mA}$$

$$U_F$$

0,85

0,95

V

Sperrstrom
Reverse current

$$U_R = 10 \text{ V}$$

$$I_R$$

100

nA

Durchbruchspannung
Breakdown voltage

$$I_R = 10 \mu\text{A}$$

$$U_{(BR)}$$

20

V

Diodenkapazität
Diode capacitance

$$f = 30 \text{ MHz}, U_R = 2 \text{ V},$$

$$U_R = 4 \text{ V}$$

$$U_R = 10 \text{ V}$$

$$C_D$$

45

55

65

pF

$$C_D$$

46

pF

$$C_D$$

35

pF

Serienwiderstand

Series resistance

$$U_R = 2 \text{ V}, f = 30 \text{ MHz}$$

$$r_s$$

0,5

1,1

Ω

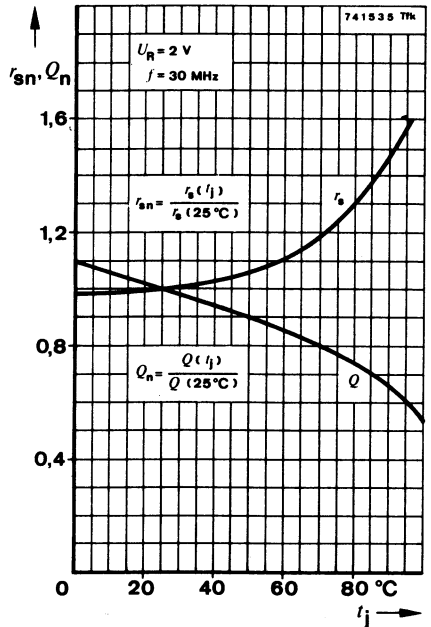
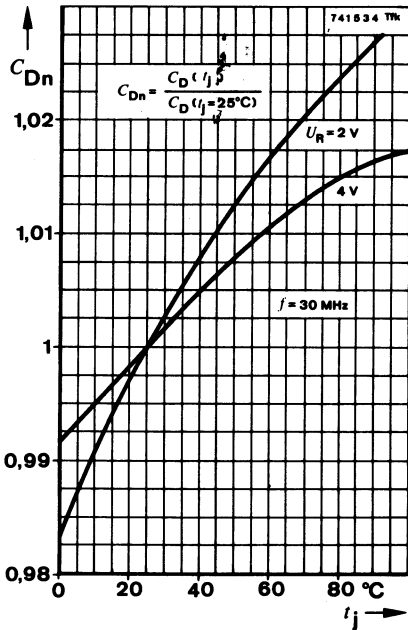
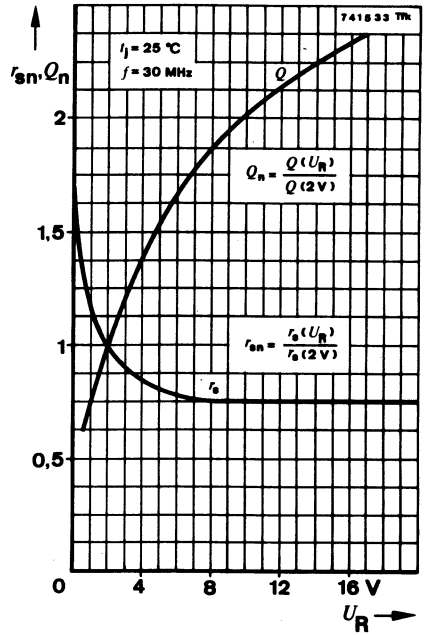
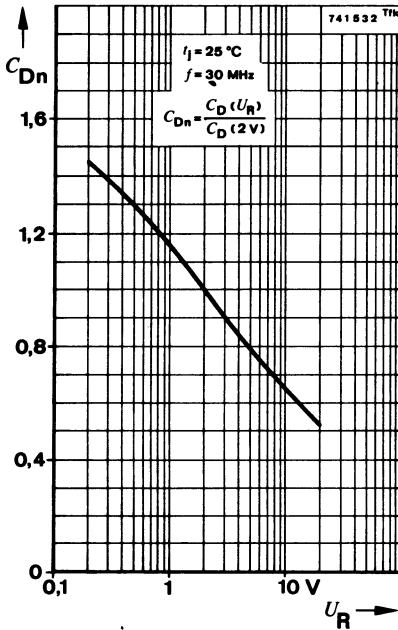
Güte

Quality

$$U_R = 2 \text{ V}, f = 30 \text{ MHz}$$

$$Q$$

200

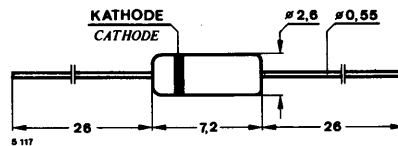


Silizium-Kapazitäts-Diode Silicon capacitance diode

Anwendungen: Nachstimschaltungen in VHF- und UHF-TV-Tunern

Applications: AFC in VHF and UHF-TV tuners

**Abmessungen in mm
Dimensions in mm**



Normgehäuse
Case
51 A 2 DIN 41880
JEDEC DO 7
Gewicht · Weight
max. 0,2 g

Absolute Grenzdaten Absolute maximum ratings

Periodische Spitzensperrspannung Repetitive peak reverse voltage	U_{RRM}	30	V
Sperrspannung Reverse voltage	U_R	30	V
Sperrschichttemperatur Junction temperature	t_j	150	°C
Lagerungstemperaturbereich Storage temperature range	t_{stg}	-55...+150	°C

Wärmewiderstand Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
 $l = 5 \text{ mm}, t_L = \text{konstant}$
constant

	Min.	Typ.	Max.
R_{thJA}			420 K/W

BA 121

Kenngrößen Characteristics

$t_j = 25^\circ\text{C}$, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Durchlaßspannung
Forward voltage

$I_F = 60\text{ mA}$

U_F 0,85 0,9 V

Sperrstrom
Reverse current

$U_R = 10\text{ V}$

$U_R = 10\text{ V}, t_j = 120^\circ\text{C}$

I_R 3 25 nA
 I_R 10 μA

Diodenkapazität
Diode capacitance

$U_R = 2\text{ V}, f = 30\text{ MHz}$

C_D 8 10 12 pF

Serienwiderstand
Series resistance

$U_R = 2\text{ V}, f = 100\text{ MHz}$

r_s 0,9 2 Ω

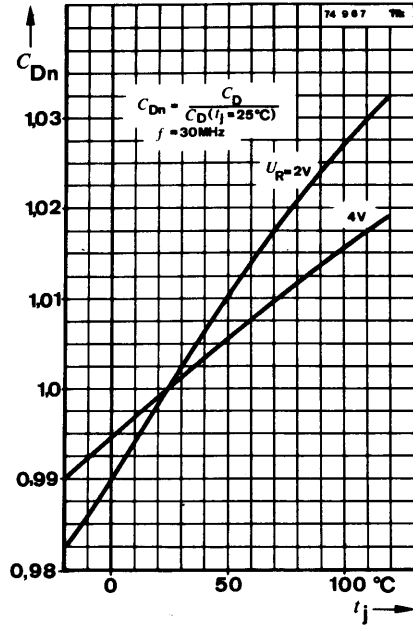
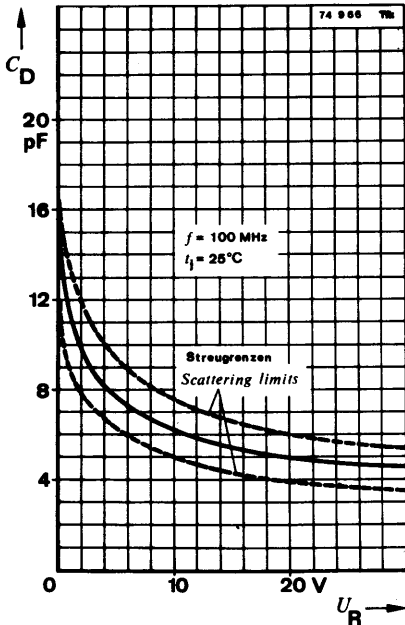
Güte
Quality

$U_R = 2\text{ V}, f = 30\text{ MHz}$

Q 600

Serieninduktivität
Series inductance

L_s 5 nH

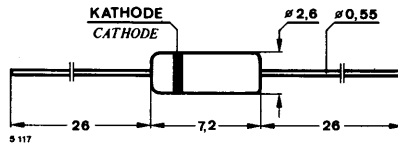


Silizium-Kapazitäts-Diode Silicon capacitance diode

Anwendungen: Automatische Nachstimmrichtungen in VHF-Tunern

Applications: AFC in VHF tuner

**Abmessungen in mm
Dimensions in mm**



Normgehäuse
Case
51 A 2 DIN 41 880
JEDEC DO 7
Gewicht · Weight
max. 0,2 g

Absolute Grenzdaten Absolute maximum ratings

Periodische Spitzensperrspannung Repetitive peak reverse voltage	U_{RRM}	30	V
Sperrspannung Reverse voltage	U_R	30	V
Sperrschichttemperatur Junction temperature	t_j	150	°C
Lagerungstemperaturbereich Storage temperature range	t_{stg}	-55...+150	°C

Wärmewiderstand Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
 $l = 5 \text{ mm}$, $t_L = \text{konstant}$
constant

	Min.	Typ.	Max.
R_{thJA}			420 K/W

BA 124

Kenngrößen Characteristics

Min. Typ. Max.

$t_j = 25^\circ\text{C}$, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Durchlaßspannung
Forward voltage

$I_F = 60\text{ mA}$

U_F 0,85 0,9 V

Sperrstrom
Reverse current

$U_R = 20\text{ V}$
 $U_R = 10\text{ V}, t_j = 120^\circ\text{C}$

I_R 50 nA
 I_R 15 μA

Diodenkapazität
Diode capacitance

$U_R = 2\text{ V}, f = 30\text{ MHz}$

Gruppe: 50	C_D	44	51	pF
Group: 55	C_D	49	56	pF
60	C_D	54	61	pF
65	C_D	59	66	pF

Serienwiderstand
Series resistance

$U_R = 2\text{ V}, f = 100\text{ MHz}$

r_s 0,5 Ω

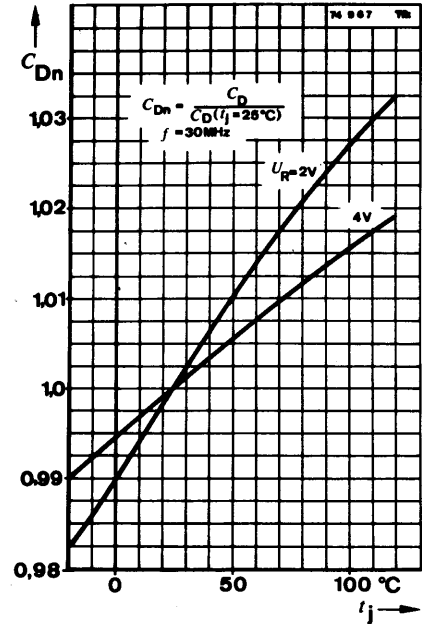
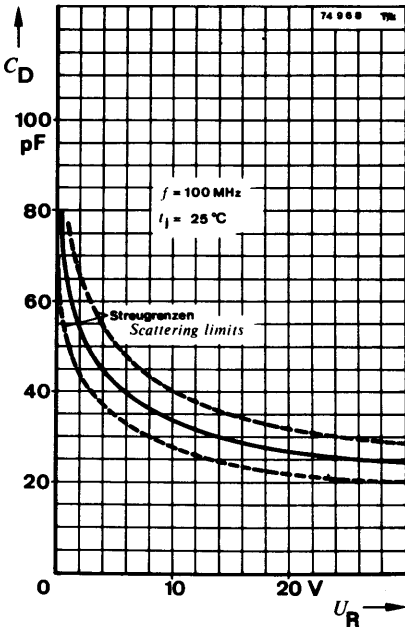
Güte
Quality

$U_R = 2\text{ V}, f = 30\text{ MHz}$

Q 190

Serieninduktivität
Series inductance

L_s 5 nH

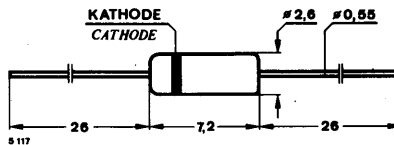


Silizium-Kapazitäts-Diode Silicon capacitance diode

Anwendungen: Automatische Nachstimmaltungen in VHF-Tunern

Applications: AFC in VHF tuner

**Abmessungen in mm
Dimensions in mm**



Normgehäuse
Case
51 A 2 DIN 41880
JEDEC DO 7
Gewicht · Weight
max. 0,2 g

Absolute Grenzwerte Absolute maximum ratings

Periodische Spitzensperrspannung <i>Repetitive peak reverse voltage</i>	U_{RRM}	30	V
Sperrspannung <i>Reverse voltage</i>	U_R	30	- V
Sperrschichttemperatur <i>Junction temperature</i>	t_j	150	°C
Lagerungstemperaturbereich <i>Storage temperature range</i>	t_{stg}	-55...+150	°C

Wärmewiderstand Thermal resistance

		Min.	Typ.	Max.	
Sperrschicht-Umgebung <i>Junction ambient</i> $l = 5 \text{ mm}, t_L = \text{konstant}$ <i>constant</i>	R_{thJA}			420	K/W

BA 125

Kenngrößen Characteristics

Min. Typ. Max.

$t_j = 25^\circ\text{C}$, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Durchlaßspannung
Forward voltage

$I_F = 60\text{ mA}$

U_F

0,85

0,9

V

Sperrstrom

Reverse current

$U_R = 20\text{ V}$

I_R

50

nA

$U_R = 10\text{ V}, t_j = 120^\circ\text{C}$

I_R

15

μA

Diodenkapazität

Diode capacitance

$U_R = 2\text{ V}, f = 30\text{ MHz}$

Gruppe: 35

C_D

29

36

pF

Group: 40

C_D

34

41

pF

45

C_D

39

46

pF

50

C_D

44

51

pF

Serienwiderstand

Series resistance

$U_R = 2\text{ V}, f = 30\text{ MHz}$

r_s

0,5

Ω

Güte

Quality

$U_R = 2\text{ V}, f = 30\text{ MHz}$

Q

260

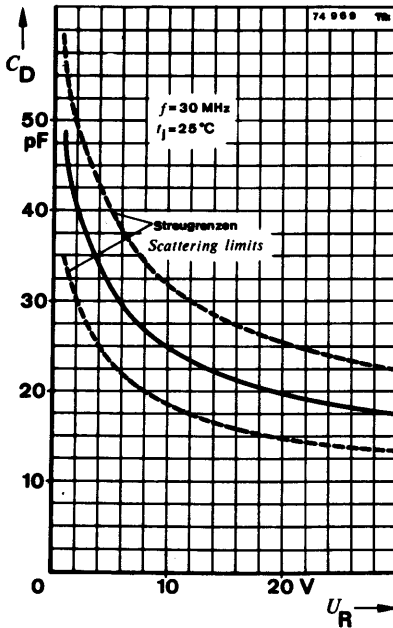
Serieninduktivität

Series inductance

L_s

5

nH



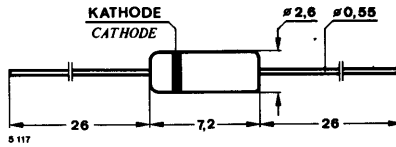


Silizium-Diode Silicon diode

Anwendungen: Allgemein

Applications: General purpose

Abmessungen in mm
Dimensions in mm



Normgehäuse
Case
51 A 2 DIN 41880
JEDEC DO 7
Gewicht · Weight
max. 0,2 g

Absolute Grenzdaten Absolute maximum ratings

Sperrspannung Reverse voltage	BA 147/25	U_R	25	V
	BA 147/50	U_R	50	V
	BA 147/100	U_R	100	V
	BA 147/150	U_R	150	V
	BA 147/230	U_R	230	V
	BA 147/300	U_R	300	V
Periodischer Durchlaßspitzenstrom Repetitive peak forward current		I_{FRM}	500	mA
Durchlaßstrom Forward current		I_F	150	mA
Sperrschichttemperatur Junction temperature		t_j	150	°C
Lagerungstemperaturbereich Storage temperature range		t_{stg}	-55...+150	°C

BA 147/...

Wärmewiderstand Thermal resistance

Min. Typ. Max.

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

$l = 4 \text{ mm}$, $t_L = \text{konstant}$
constant

R_{thJA}

500 K/W

Kenngrößen Characteristics

$t_j = 25^\circ\text{C}$, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Durchlaßspannung
Forward voltage

$I_F = 50 \text{ mA}$

U_F

1 V

Sperrstrom
Reverse current

$U_R = 25 \text{ V}$	BA 147/25	I_R	500	nA
$U_R = 50 \text{ V}$	BA 147/50	I_R	500	nA
$U_R = 100 \text{ V}$	BA 147/100	I_R	1	μA
$U_R = 150 \text{ V}$	BA 147/150	I_R	1,5	μA
$U_R = 230 \text{ V}$	BA 147/230	I_R	2	μA
$U_R = 300 \text{ V}$	BA 147/300	I_R	3	μA

I_R
 I_R
 I_R
 I_R
 I_R
 I_R

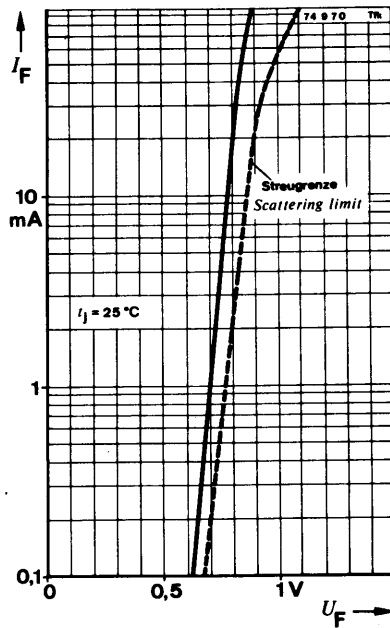
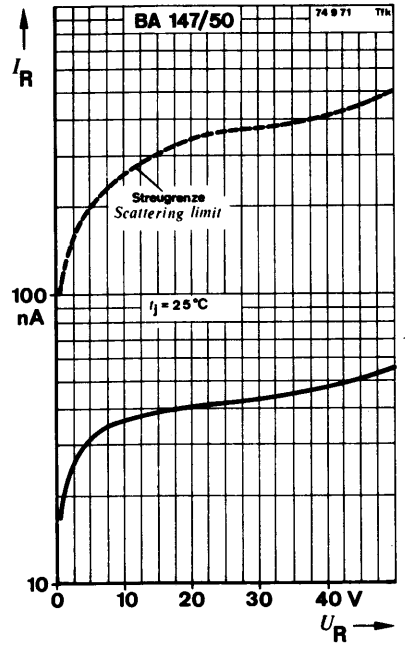
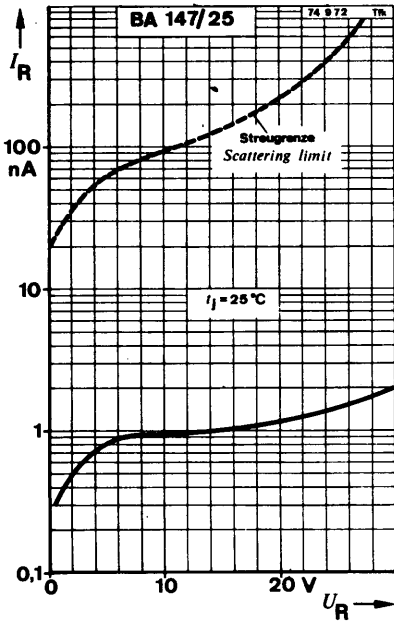
500 nA
500 nA
1 μA
1,5 μA
2 μA
3 μA

$t_j = 100^\circ\text{C}$

$U_R = 10 \text{ V}$	BA 147/25, BA 147/50	I_R	15	μA
$U_R = 50 \text{ V}$	BA 147/100	I_R	30	μA
$U_R = 100 \text{ V}$	BA 147/150	I_R	50	μA
$U_R = 150 \text{ V}$	BA 147/230	I_R	75	μA
$U_R = 200 \text{ V}$	BA 147/300	I_R	100	μA

I_R
 I_R
 I_R
 I_R
 I_R

15 μA
30 μA
50 μA
75 μA
100 μA

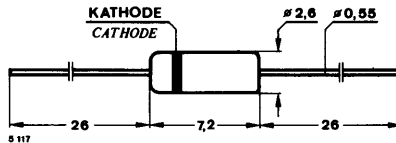


Silizium-Diffusions-Diode
Silicon diffusion diode

Anwendungen: Klemmschaltungen in Farb-FS-Geräten mit hohen Betriebsspannungen

Applications: *Clamping circuits in colour TV-receivers, with high supply voltage*

Abmessungen in mm
Dimensions in mm



Normgehäuse
Case
51 A 2 DIN 41880
JEDEC DO 7
Gewicht · Weight
max. 0,2 g

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Periodische Spitzensperrspannung
Repetitive peak reverse voltage

$$\frac{t_p}{T} = 0,01, t_p \leq 0,1 \text{ ms}$$

U_{RRM} 350 V

Sperrspannung
Reverse voltage

U_R 300 V

Periodischer Durchlaßspitzenstrom
Repetitive peak forward current

$$\frac{t_p}{T} = 0,01, t_p \leq 10 \text{ ms}$$

I_{FRM} 3 A

Durchlaßstrom
Forward current

I_F 300 mA

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

t_j 150 °C

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

t_{stg} -65...+150 °C

BA 173

Wärmewiderstand Thermal resistance

Min. Typ. Max.

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

$l = 4 \text{ mm}$, $t_L = \text{konstant}$
constant

R_{thJA} 450 K/W

Kenngrößen Characteristics

$t_j = 25^\circ\text{C}$

Durchlaßspannung
Forward voltage

$I_F = 100 \text{ mA}$

U_F 1 V

Sperrstrom
Reverse current

$U_R = 300 \text{ V}$

I_R 0,08 1 μA

Diodenkapazität
Diode capacitance

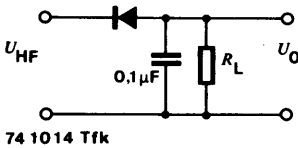
$f = 1 \text{ MHz}$, $U_R = 30 \text{ V}$
 $U_R = 150 \text{ V}$

C_D 3,4 pF
 C_D 2 pF

Rückwärtserholzeit
Reverse recovery time

$I_F = I_R = 10 \text{ mA}$, $i_R = 1 \text{ mA}$

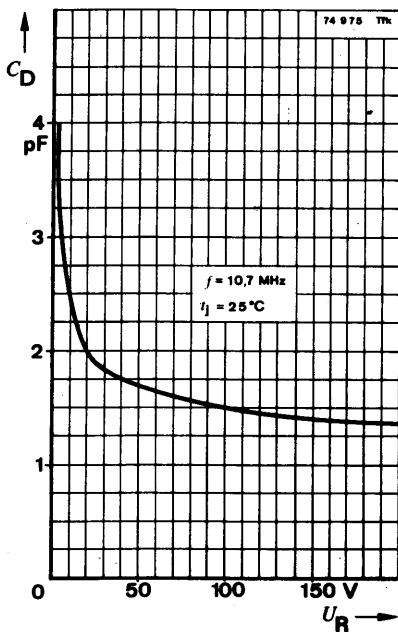
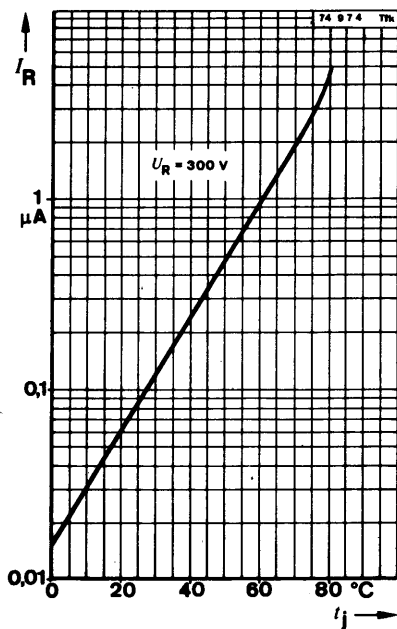
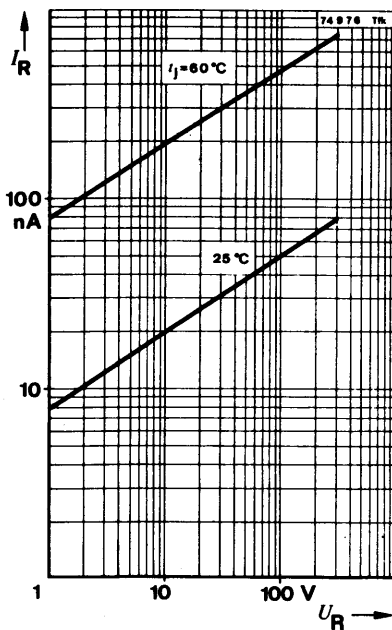
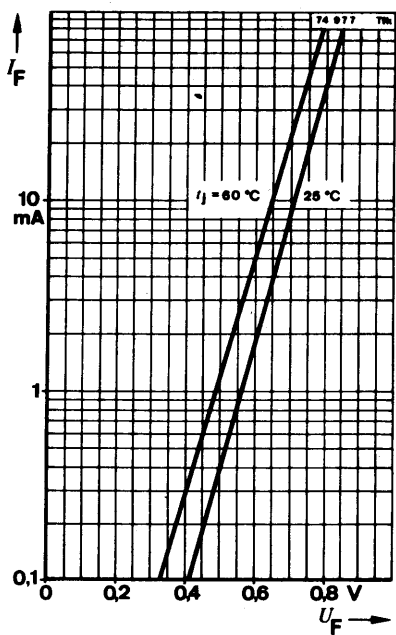
t_{rr} 350 500 ns



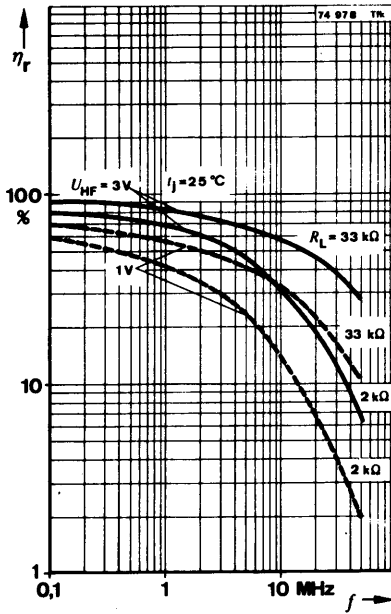
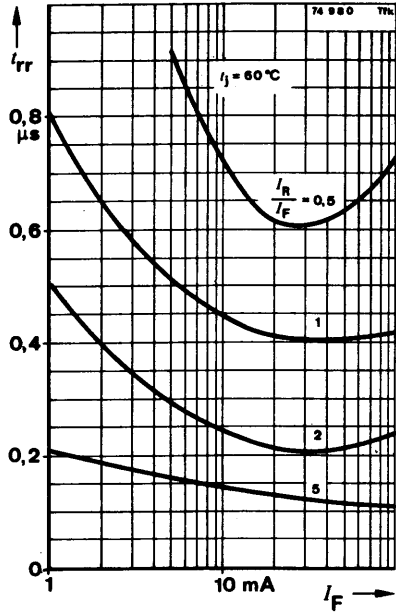
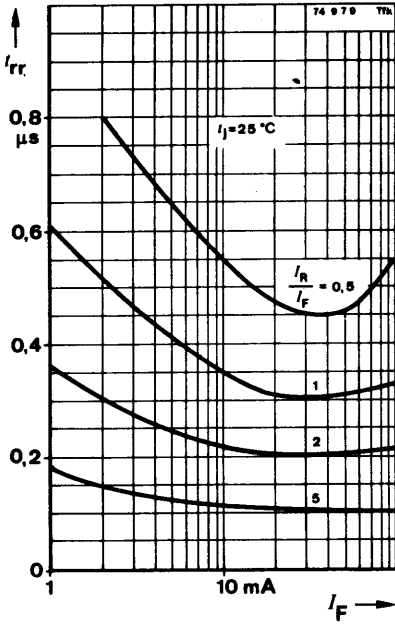
$R_L = 2\text{k}\Omega$ bzw. $33\text{k}\Omega$

$$\eta_r = \frac{U_O \times 100\%}{U_{HF}}$$

Meßschaltung für: η_r
Test circuit for: η_r



BA 173

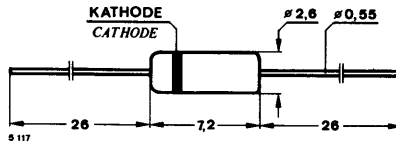


Silizium-Diode Silicon diode

Anwendungen: Antennenschutzdiode

Applications: Aerial protection

**Abmessungen in mm
Dimensions in mm**



Normgehäuse
Case
51 A 2 DIN 41 880
JEDEC DO 7
Gewicht · Weight
max. 0,2 g

Kenngrößen Characteristics

Min. Typ. Max.

$$t_j = 25^\circ\text{C}$$

Durchlaßspannung
Forward voltage
 $I_F = 400 \text{ mA}$

$$U_{F^{(1)2}} \quad 1,5 \quad \text{V}$$

Sperrstrom
Reverse current
 $U_R = 20 \text{ V}$

$$I_R \quad 1 \quad \mu\text{A}$$

Durchbruchspannung
Breakdown voltage
 $I_R = 1 \text{ mA}$

$$U_{(BR)^{(2)}} \quad 100 \quad \text{V}$$

Diodenkapazität
Diode capacitance

$$U_R = 2 \text{ V}, f = 30 \text{ MHz}$$

$$C_D \quad 15 \quad \text{pF}$$

1) $\frac{t_p}{T} = 0,01$, $t_p = 0,3 \text{ ms}$

2) Die Diode kann mehrmals die Entladung eines auf 12 kV aufgeladenen Kondensators von 1 nF über 2 kΩ in Durchlaß- und Sperr-Richtung vertragen.

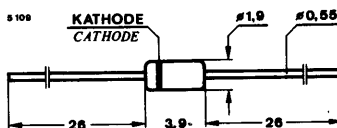
The diode can endure for several times the discharge of a capacitor of 1 nF which was charged at 12 kV across 2 kΩ in forward and reverse direction.

Silizium-Epitaxial-Planar-Diode Silicon epitaxial planar diode

Anwendungen: Allgemein

Applications: General purpose

Abmessungen in mm
Dimensions in mm



Normgehäuse
Case
54 A 2 DIN 41880
JEDEC DO 35
Gewicht · Weight
max. 0,15 g

Absolute Grenzdaten Absolute maximum ratings

Periodische Sperrsperrspannung <i>Repetitive peak reverse voltage</i>	U_{RRM}	60	V
Sperrspannung <i>Reverse voltage</i>	U_R	50	V
Stoßdurchlaßstrom <i>Surge forward current</i> $t_p \leq 1 \mu s$	I_{FSM}	2	A
Periodischer Durchlaßspitzenstrom <i>Repetitive peak forward current</i>	I_{FRM}	450	mA
Durchlaßstrom <i>Forward current</i>	I_F	200	mA
Durchlaßstrom, Mittelwert <i>Average forward current</i>	I_{FAV}	150	mA
Sperrschichttemperatur <i>Junction temperature</i>	t_j	200	°C
Lagerungstemperaturbereich <i>Storage temperature range</i>	t_{stg}	-65...+200	°C

BA 204

Wärmewiderstand Thermal resistance

Min. Typ. Max.

Sperrschicht-Umgebung

Junction ambient

$l = 4 \text{ mm}$, $t_L = \text{konstant}$
constant

R_{thJA}

350 K/W

Kenngößen Characteristics

$t_j = 25^\circ\text{C}$, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Durchlaßspannung

Forward voltage

$I_F = 100 \text{ mA}$

$U_F^{1)}$

1 V

Sperrstrom

Reverse current

$U_R = 30 \text{ V}$

I_R

100 nA

$U_R = 30 \text{ V}$, $t_j = 150^\circ\text{C}$

I_R

100 μA

Durchbruchspannung

Breakdown voltage

$I_R = 1 \mu\text{A}$

$U_{(BR)}$

50

V

Diodenkapazität

Diode capacitance

$U_R = 0$, $f = 1 \text{ MHz}$

C_D

5 pF

Rückwärtserholzeit

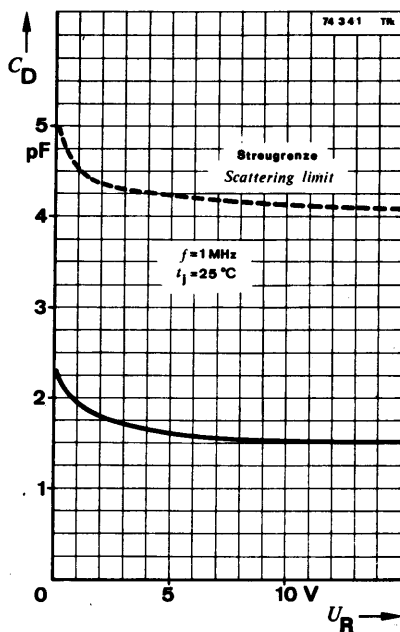
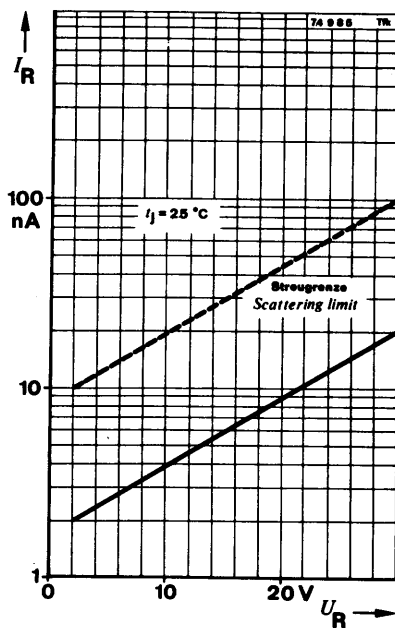
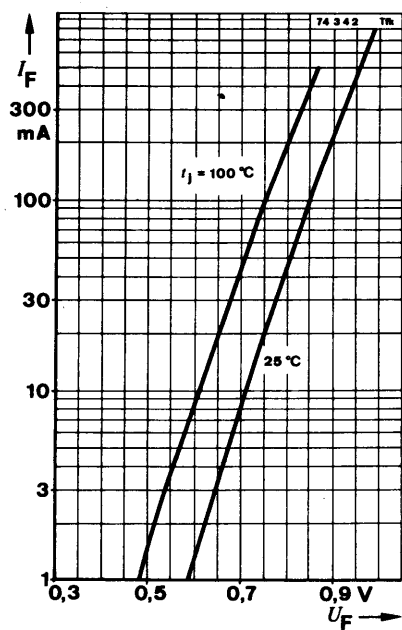
Reverse recovery time

$I_F = I_R = 10 \text{ mA}$, $i_R = 1 \text{ mA}$

t_{rr}

10 ns

¹⁾ $\frac{t_p}{T} = 0,01$, $t_p = 0,3 \text{ ms}$



Silizium-PIN-Diode Silicon-PIN-Diode

Anwendungen: Stromgesteuerter HF-Widerstand in regelbaren Netzwerken

Applications: Current controlled HF resistance in adjustable attenuators

Besonderes Merkmal:

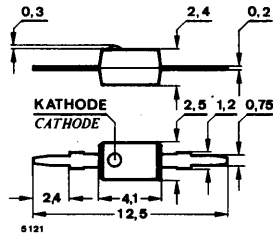
- Großer Frequenzbereich 10 MHz...1 GHz

Feature:

- Wide frequency range 10 MHz...1 GHz

Vorläufige technische Daten · Preliminary specifications

Abmessungen in mm
Dimensions in mm



Kunststoffgehäuse
Plastic case
SOD 23
Gewicht · Weight
max. 0,1 g

Absolute Grenzwerte Absolute maximum ratings

Sperrspannung Reverse voltage	U_R	30	V
Durchlaßstrom Forward current	I_F	50	mA
Sperrschichttemperatur Junction temperature	t_j	125	°C
Lagerungstemperaturbereich Storage temperature range	t_{stg}	-55 +125	°C

Kenngrößen Characteristics

Min. Typ. Max.

$t_{amb} = 25^{\circ}C$, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Durchlaßspannung

Forward voltage

$I_F = 50 \text{ mA}$

U_F

1

V

Sperrstrom

Reverse current

$U_R = 30 \text{ V}$

I_R

50

nA

Diodenkapazität

Diode capacitance

$U_R = 0, f = 100 \text{ MHz}$

C_D

0,5

pF

Differentieller Durchlaßwiderstand

Differential forward resistance

$I_F = 1,5 \text{ mA}, f = 100 \text{ MHz}$

r_f

50

Ω

Sperrimpedanz

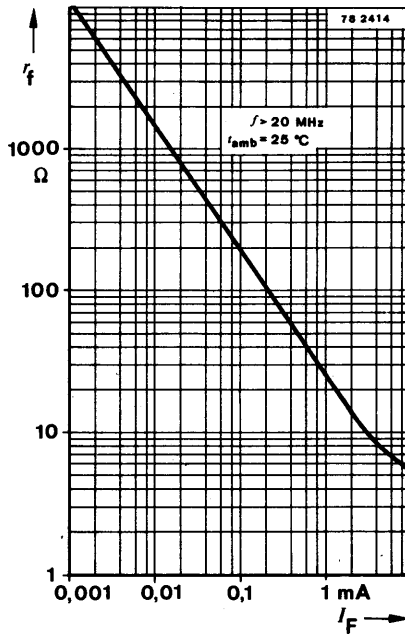
Reverse impedance

$U_R = 0, f = 100 \text{ MHz}$

z_r

9

k Ω



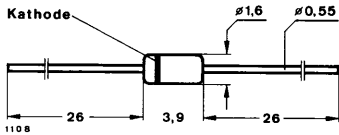
Silizium-PIN-Dioden

Anwendungen: Stromgesteuerter HF-Widerstand in regelbaren Netzwerken

Besondere Merkmale: ▾

- Großer Frequenzbereich 10 MHz...1 GHz

Abmessungen in mm



Normgehäuse
54 A2 DIN 41 880
JEDEC DO 35
Gewicht max. 0,15 g

Bestemp lung: Klartext

Absolute Grenzdaten

Sperrspannung	U_R	30	V
Durchlaßstrom	I_F	50	mA
Sperrschichttemperatur	T_j	125	°C
Lagerungstemperaturbereich	T_{stg}	- 55...+ 125	°C

Kenng rößen

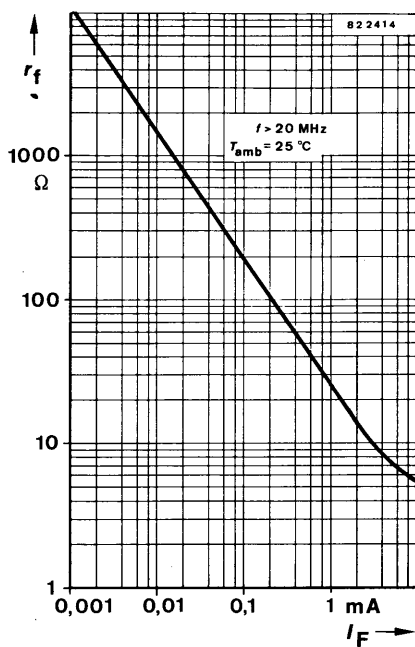
$T_{amb} = 25 \text{ °C}$, falls nicht anders angegeben

		Min.	Typ.	Max.
Durchlaßspannung				
$I_F = 20 \text{ mA}$	U_F			1 V
Sperrstrom				
$U_R = 30 \text{ V}$	I_R			50 nA
Diodenkapazität				
$U_R = 0, f = 100 \text{ MHz}$	C_D			0,5 pF
Differentieller Durchlaßwiderstand				
$I_F = 1,5 \text{ mA}, f = 100 \text{ MHz}$	r_t			50 Ω
Sperrimpedanz				
$U_R = 0, f = 100 \text{ MHz}$	Z_t	4,5		k Ω
	Z_t	9		k Ω

Wärmewiderstand

Sperrschichtumgebung				
$l = 4 \text{ mm}, t_L = \text{konstant}$	R_{thJA}		350	K/W

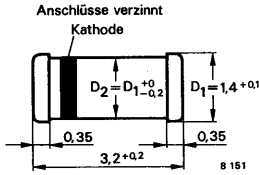
BA 479 G · BA 479 S



Silizium-Planar-Dioden

Anwendungen: Bereichsumschaltung in VHF-Tunern

Abmessungen in mm



Glasgehäuse
SOD 80
Mini MELF
Gewicht max. 0,1 g

Absolute Grenzdaten

Sperrspannung	U_R	35	V
Durchlaßstrom	I_F	100	mA
Sperrschichttemperatur	T_j	150	°C
Lagerungstemperaturbereich	T_{stg}	- 55 + 150	°C

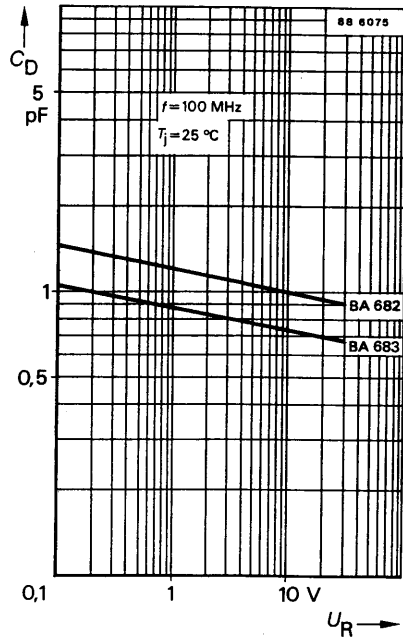
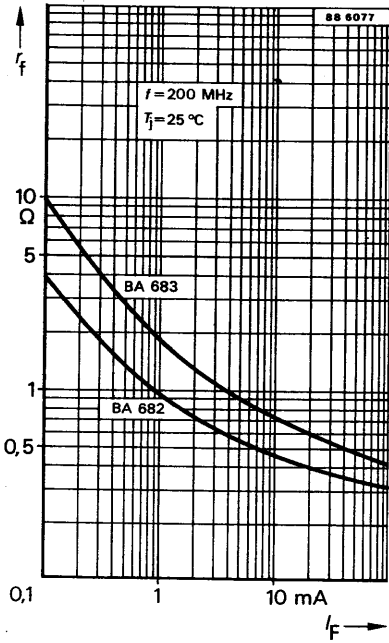
Maximaler Wärmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung auf Leiterplatte 50 mm x 50 mm x 1,6 mm	R_{thJA}	500	K/W
--	------------	-----	-----

Kenngrößen

		Min.	Typ.	Max.	
$T_j = 25\text{ °C}$					
Durchlaßspannung $I_F = 100\text{ mA}$	U_F			1	V
Sperrstrom $U_R = 20\text{ V}$	I_R			50	nA
Diodenkapazität $f = 100\text{ MHz}, U_R = 1\text{ V}$	C_D			1,5	pF
$U_R = 3\text{ V}$	C_D			1,25	pF
	C_D			1,2	pF
Differentieller Durchlaßwiderstand $f = 200\text{ MHz}, I_F = 3\text{ mA}$	r_f			0,7	Ω
	r_f			1,2	Ω
$I_F = 10\text{ mA}$	r_f			0,5	Ω
	r_f			0,9	Ω
Sperrimpedanz $U_R = 1\text{ V}, f = 100\text{ MHz}$	z_r	100			kΩ

BA 682 · BA 683





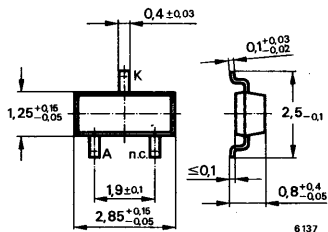
Silizium-PIN-Dioden

Anwendungen: Stromgesteuerter HF-Widerstand in regelbaren Netzwerken

Besondere Merkmale:

- Großer Frequenzbereich 10 MHz...1 GHz

Abmessungen in mm



Standard Kunststoffgehäuse
23 A3 DIN 41869/8
JEDEC TO 236
SOT 23
Gewicht max. 0,02 g

Bestemp lung: BA 779 PN
BA 779 S + PN

Absolute Grenzdaten

Sperrspannung	U_R	30	V
Durchlaßstrom	I_F	50	mA
Sperrschichttemperatur	T_j	125	°C
Lagerungstemperaturbereich	T_{stg}	- 55...+ 125	°C

Maximaler Wärmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung auf Leiterplatte 50 mm x 50 mm x 1,6 mm	R_{thJA}	500	K/W
--	------------	-----	-----

Kenngrößen

$T_{amb} = 25 \text{ °C}$, falls nicht anders angegeben

		Min.	Typ.	Max.	
Durchlaßspannung				1	V
$I_F = 20 \text{ mA}$	U_F				
Sperrstrom				50	nA
$U_R = 30 \text{ V}$	I_R				
Diodenkapazität				0,5	pF
$U_R = 0, f = 100 \text{ MHz}$	C_D				
Differentieller Durchlaßwiderstand				50	Ω
$I_F = 1.5 \text{ mA}, f = 100 \text{ MHz}$	r_f				
Sperrimpedanz					
$U_R = 0, f = 100 \text{ MHz}$	z_r	5			k Ω
	z_r	9			k Ω

BA 779
BA 779 S

BA 779 · BA 779S

